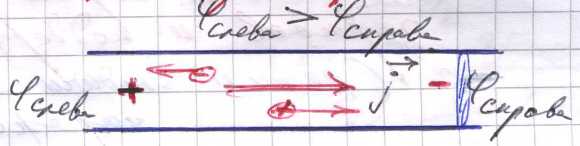
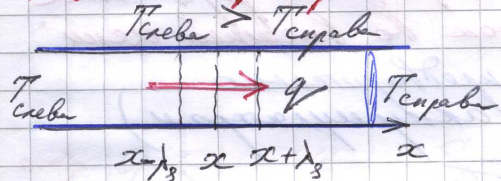


Лекция 18 Электрический ток, как явление переноса. Энергетические превращения в цепи постоянного тока. Токи в проводящих средах. Моделирование электромагнитных полей. Сопротивление. Заземление

§1. Электрический ток, как явление переноса.

Электрический ток, как и теплопроводность, является явлением переноса. Между соответствующими величинами, потоком тепла, при наличии градиента температуры, и плотностью электрического тока, при наличии градиента потенциала, существует тесная связь, так, что коэффициент теплопроводности α выражается через электропроводность σ - электрическую проводимость.



$$Q = -C_{уд} \cdot m \frac{1}{6} n \bar{v} \cdot 2\lambda_s \frac{dT}{dx} = -\alpha \frac{dT}{dx}$$

$$j = \sigma E = -\frac{nq^2 \tau}{m} \frac{d\phi}{dx} = -\sigma \frac{d\phi}{dx}$$

$$\alpha = C_{уд} \cdot m \frac{1}{3} n \bar{v} \lambda_s = \frac{C_{уд} \cdot m \cdot n \cdot \bar{v} \cdot \lambda_s}{N_A \cdot M \cdot 3}$$

$$= \frac{3}{2} \frac{N_A k_B}{N_A} \cdot \frac{n m \bar{v}^2}{2} \frac{\lambda_s}{m \bar{v} \cdot 3}$$

$$= n k_B \cdot \frac{m \bar{v}^2}{2} \cdot \frac{\tau_s}{m} = \frac{3}{2} n k_B \frac{\tau_s}{m} T$$

$$\frac{\alpha}{\sigma} = \frac{3}{2} \left(\frac{k_B}{q} \right)^2 T$$

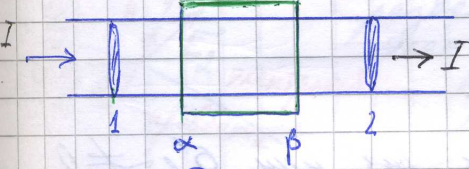
Закон Видемана-Франца.

λ_s - длина свод. пробега,
 τ_s - время свод. пробега

$$\lambda_s / \bar{v} = \tau_s, \quad \frac{m \bar{v}^2}{2} = \frac{3 k_B T}{2}$$

§2. Энергетические превращения в цепи постоянного тока

Проследим за энергетическими превращениями на участке цепи с постоянным током. Согласно закону Ома для участка цепи, содержащего ЭДС:



$$I \cdot R_{12} = \phi_1 - \phi_2 + \mathcal{E}_{12}$$

$$\phi_1 - \phi_2 = I R_{12} - \mathcal{E}_{12}$$

Работа электрического тока на участке цепи равна, по определению, работе сил поля по перемещению заряда $q = It$:

$$A_{эл.тока} \text{ за время } t = I \cdot t (\phi_1 - \phi_2) = I^2 R_{12} t - \mathcal{E}_{12} I \cdot t$$

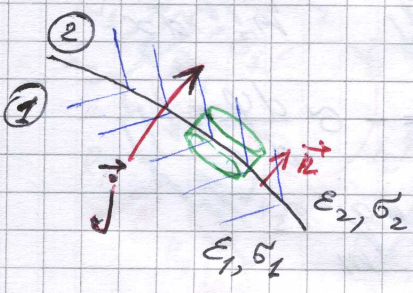
Воспользуемся формулой как раз и отражает энергетические превращения на участке цепи. Рассмотрим частный случай короткого замыкания.

$A_{эл.тока} = It(\varphi_1 - \varphi_2) = I^2 R_{12} t - \epsilon_{12} I t$
 (A) $\epsilon_{12} = 0 \Rightarrow A_{эл.тока} = I^2 R_{12} t = \Delta Q$ - Закон Джоуля-Ленца
 Работа эл. тока в диэлектрике идет на тепловые потери в рассматриваемом участке.

(Б) $R_{12} = 0, \varphi_1 > \varphi_2 \Rightarrow It(\varphi_1 - \varphi_2) = -\epsilon_{12} I t > 0 \Rightarrow \epsilon_{12} < 0$
 ЭДС в диэлектрике работает в режиме подзарядки.
 (Статус ретинки зарядов аккумулятора)

(В) $R_{12} = 0, \varphi_1 < \varphi_2 \Rightarrow It(\varphi_1 - \varphi_2) = -\epsilon_{12} I t < 0 \Rightarrow \epsilon_{12} > 0$
 ЭДС в диэлектрике работает в режиме разделения зарядов и поддерживает ток во внешней цепи (решение отдачи энергии предварительно заряженной аккумулятору).

§3. Токи в проводящих средах. Граничные условия для полей при наличии постоянных токов.



Три граничные условия постоянных электрических токов в проводящих средах с различными, соприкасающимися друг с другом материалами, с различными диэлектрическими проницаемостями и проводимостями в дополнение к граничным условиям

$$D_{2n} - D_{1n} = \sigma_{своб}, \quad E_{2c} = E_{1c}$$

координатное условие, дополняющее, граничное условие на нормальную составляющую электрического поля. Это условие легко получить из уравнения $\nabla \cdot \vec{j} = 0$

$$\nabla \cdot \vec{j} = 0 \Leftrightarrow \oint \vec{j} \cdot d\vec{S} = (j_{2n} - j_{1n}) \Delta S = \Delta S (\sigma_2 E_{2n} - \sigma_1 E_{1n}) = 0$$

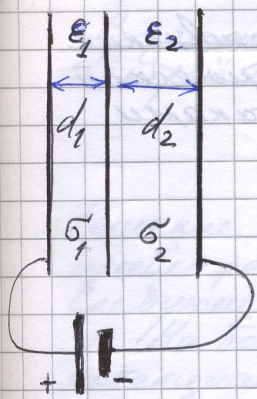
$\vec{j} = \sigma \vec{E}$

На границе раздела двух сред имеем, таким образом, следующие граничные условия:

$$\begin{cases} \sigma_1 E_{1n} = \sigma_2 E_{2n} \\ \epsilon_0 \epsilon_2 E_{2n} - \epsilon_0 \epsilon_1 E_{1n} = \sigma_{своб} \end{cases}$$

Выполнение этих условий возможно как раз при $\sigma_{своб} \neq 0$, т.е. при протекании через границу раздела двух материалов электрического тока, в стационарном режиме на границу раздела падает заряд $\sigma_{своб}$ и сохраняется на этой границе.

Для иллюстрации применим выписанные граничные условия рассмотрим протекание электрического постоянного тока через плоский конденсатор, заполненный двумя слоями диэлектриков с (ϵ_1, σ_1) и (ϵ_2, σ_2) .



Пусть к плоскому конденсатору с двумя слоями диэлектриков, обладающих некоторыми проводимостями σ_1 и σ_2 , приложено напряжение U . Определим поля E_1 и E_2 в слоях диэлектриков и заряд $q = \sigma S$, который стекает на границу раздела диэлектриков, в режиме постоянного тока.

Идем из системы уравнений:

$$E_1 d_1 + E_2 d_2 = U, \quad \leftarrow \int \vec{E} d\vec{l} = - \int \vec{\nabla} \varphi d\vec{l}$$

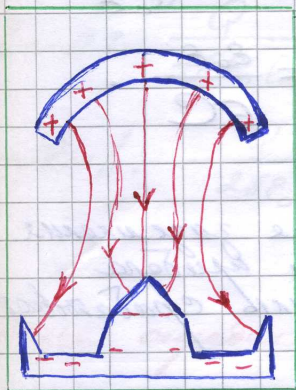
$$\sigma_1 E_1 = \sigma_2 E_2.$$

$$\Rightarrow E_1 d_1 + \frac{\sigma_1 E_1}{\sigma_2} d_2 = U \rightarrow \begin{cases} E_1 = \frac{U}{d_1 + \frac{\sigma_1}{\sigma_2} d_2} \\ E_2 = \frac{E_1}{(\sigma_2/\sigma_1)} = \frac{U}{\frac{\sigma_2}{\sigma_1} d_1 + d_2} \end{cases}$$

$$\Rightarrow q_{\text{между}} = \sigma S = (\epsilon_0 \epsilon_2 E_2 - \epsilon_0 \epsilon_1 E_1) S = S \left(\frac{\epsilon_0 \epsilon_2 U}{\frac{\sigma_2}{\sigma_1} d_1 + d_2} - \frac{\epsilon_0 \epsilon_1 U}{d_1 + \frac{\sigma_1}{\sigma_2} d_2} \right) = S \frac{\epsilon_0 U (\sigma_1 \epsilon_2 - \sigma_2 \epsilon_1)}{\sigma_2 d_1 + d_2 \sigma_1} \neq 0$$

Только при специальном условии $\sigma_1 \epsilon_2 = \sigma_2 \epsilon_1$ заряд на границу раздела диэлектриков не стекает.

§ 4 Моделирование электростатических полей с помощью токовых линий электролитической ванны.



При создании физических установок со сложным рисунком электростатических полей между различными частями этих установок оказывается проще промоделировать такие поля, нежели реально их рассчитать, решая уравнение Лапласа с граничными условиями.

Триггера моделирования электростатических полей заключается в следующем.

Установку погружают в электролитическую ванну, между электродами подают напряжение, которое приводит к стационарному постоянному току. На границе раздела проводящей части прибора с σ_1 и электролита с $\sigma_2 \ll \sigma_1$ должны выполняться граничные условия:

$$\sigma_1 E_{1n} = \sigma_2 E_{2n}, \quad E_{1\tau} = E_{2\tau}, \quad \text{т.е.}$$

Словосе линии

поля \vec{E} в электролите параллельны токовой линии,

т.к. $\vec{j} = \sigma \vec{E}$

более того, словосе линии \vec{E} подходят к проводящей частям перпендикулярно!

$$\sigma_1 E_1 \cos \theta_1 = \sigma_2 E_2 \cos \theta_2, \quad E_1 \sin \theta_1 = E_2 \sin \theta_2$$

$$\Rightarrow \sigma_1 \sigma_2 \theta_1 = \sigma_2 \sigma_1 \theta_2, \quad \text{при } \sigma_1 \gg \sigma_2$$

$$\Rightarrow \sigma_2 \theta_1 = \frac{\sigma_2}{\sigma_1} \sigma_2 \theta_2 \rightarrow 0, \quad \theta_1 \rightarrow \frac{\pi}{2}$$

$$\theta_1 \sim \frac{\pi}{2}, \quad \theta_2 \ll \frac{\pi}{2}, \quad \theta_2 \sim 0^\circ$$

Токовые линии с высокой точностью моделируют электростатическое поле.

В закрывание данного раздела рассмотрим сопротивление диэлектрика с проводимостью σ и диэлектрической проницаемостью ϵ , заключенного между пластинами конденсатора:



$$I = jS = \sigma E S = \sigma \frac{D}{\epsilon_0 \epsilon} S = \sigma \frac{\int \vec{D} \cdot d\vec{S}}{\epsilon_0 \epsilon} = \frac{\sigma Q}{\epsilon_0 \epsilon}$$

$$\Rightarrow R = \frac{U}{I} = \frac{Q}{C I} = \frac{\epsilon_0 \epsilon}{\sigma C}$$

S-Гауссова поверхность

Получилось также вывести закон, по которому изменяется заряд $Q(t)$ на обкладке конденсатора, при его разрядке через проводящий диэлектрик. Имеем согласно закону сохранения электрического заряда:

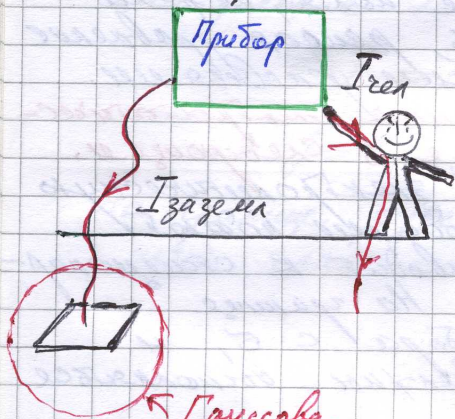
$$dQ = -jS dt = -\sigma E S dt = -\frac{\sigma}{\epsilon_0 \epsilon} D S dt = -\frac{\sigma}{\epsilon_0 \epsilon} Q dt \Rightarrow \frac{dQ}{Q} = -\frac{\sigma}{\epsilon_0 \epsilon} dt \Rightarrow$$

$$\Rightarrow Q(t) = Q(0) e^{-\frac{\sigma}{\epsilon_0 \epsilon} t}, \quad I = \frac{dQ}{dt} = -\frac{Q(0) \sigma}{\epsilon_0 \epsilon} e^{-\frac{\sigma}{\epsilon_0 \epsilon} t} =$$

$$\Rightarrow I(t) = -\frac{Q(0) \sigma}{\epsilon_0 \epsilon} = -\frac{Q(0) \sigma}{\epsilon_0 \epsilon} = -\frac{U \sigma C}{\epsilon_0 \epsilon} \Rightarrow R = \frac{U}{I} = \frac{\epsilon_0 \epsilon}{\sigma C}$$

результат, это и есть

§5. Сопротивление заземления.



Поясни принцип действия заземления. При коротком замыкании прибора через человека на Землю срабатывает и заземление, при этом

$$I_{земля} R_{земля} = I_{чел} R_{чел}$$

$$\Rightarrow I_{чел} = I_{земля} \frac{R_{земля}}{R_{чел}}$$

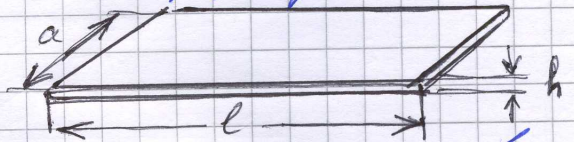
Если, что $R_{земля}$ должно быть достаточно мало, чтобы $I_{чел} \ll I_{земля}$

Относительно заземление устраивают, закапывая в Землю, на достаточную глубину, металлическую пластину. Сопротивление заземления может быть выражено через электрическую пластину следующим образом. Рассмотрим электр. ток через заземление, исходящее из закрытой Гауссовой поверхности, показанную на рисунке:

$$\oint_S \vec{j} \cdot d\vec{S} = I_{земля} = \frac{\sigma}{\epsilon_0 \epsilon} \int \vec{D} \cdot d\vec{S} = \frac{\sigma Q}{\epsilon_0 \epsilon} \Rightarrow R_{земля} = \frac{U}{I_{земля}} = \frac{Q \epsilon_0 \epsilon}{\sigma Q} = \frac{\epsilon_0 \epsilon}{\sigma C}$$

В заключение этого раздела рассчитаем, н.е. оценим, электроемкость проводящей плиты с размерами

$$l \gg a \gg h$$



Решение задачи будет носить приближенный, т.е. оценочный характер, и заключается в следующем.

На больших расстояниях от плиты, т.е. при $r \gg l$, потенциал плиты с зарядом Q , есть потенциал точечного заряда:

$$r \gg l: \varphi(r) \approx \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r}$$

На расстояниях от плиты $l \gg r \gg a$ плиту можно представить себе как тонкую нить, потенциал которой имеет вид ($\lambda = \frac{Q}{l}$ - линейная плотность заряда нити):

$$a \ll r \ll l: \varphi(r) = -\frac{Q}{l 2\pi\epsilon_0} \ln r + C_1, \quad C_1 - \text{какой-то константа}$$

Наконец, при $r \ll a$, плиту можно заменить на бесконечную плоскость с плотностью заряда $\sigma = \frac{Q}{al}$ и потенциалом:

$$r \ll a: \varphi(r) = -\frac{Qr}{al 2\epsilon_0} + C_2, \quad C_2 - \text{также какой-то константа}$$

Потенциал $\varphi(r)$ на границах областей т.е. при $r \sim l \sim a$ и $r \sim a \sim h$ необходимо считать, что приводит к уравнениям для определения констант C_1 и C_2 :

$$r \sim l \sim a: \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 l} \approx -\frac{Q}{l 2\pi\epsilon_0} \ln l + C_1 \Rightarrow C_1 = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 l} + \frac{Q}{l 2\pi\epsilon_0} \ln l$$

$$r \sim a \sim h: -\frac{Q}{2\pi\epsilon_0 l} \ln a + C_1 = -\frac{Q}{2\pi\epsilon_0 l} \ln a + \frac{Q}{2\pi\epsilon_0 l} \ln l + \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 l} = -\frac{Q}{2\epsilon_0 l} + C_2 \Rightarrow C_2 = \frac{Q}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{l}{a} + \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 l} + \frac{Q}{2\epsilon_0 l}$$

Далее определяется потенциал самой пластины, т.е. $\varphi(r=0)$:

$$\varphi_{\text{плас.}} = \varphi(0) = C_2 = Q \left(\frac{1}{2\pi\epsilon_0 l} \ln \frac{l}{a} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0 l} + \frac{1}{2\epsilon_0 l} \right)$$

а затем находим и электроемкость пластины, как зарядка-ного проводника:

$$C \approx \frac{Q}{\varphi(0)} \approx \frac{1}{\frac{1}{2\pi\epsilon_0 l} \ln \frac{l}{a} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0 l} + \frac{1}{2\epsilon_0 l}} = \frac{2\pi\epsilon_0 l}{\ln \frac{l}{a} + \pi}$$

и соотношение заземления, устроенного с помощью данной металлической плиты:

$$R_{\text{заземл}} \approx \frac{\epsilon_0 \epsilon}{\sigma C} = \frac{\epsilon (\ln \frac{l}{a} + \pi)}{2\pi l \sigma}$$

$l \gg a$ - размеры плиты,

σ - проводимость

и ϵ - диэлектрическая проницаемость плас-тины, где законо-вается плита